



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	金属源漏SOI MOS晶体管及其形成方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201110161231.7
申请日期:	2011-06-15
专利号:	201110161231.7
第一发明人:	赵超;罗军;钟汇才;王文武
实施情况:	授权
专利证书号:	201110161231.7
其它备注:	十室

